Development of 20kW input power coupler for 1.3GHz ERL main linac ---- Component test at 30kW IOT test stand ----

Hiroshi Sakai^{1,A)}, Kensei Umemori^{A)}, Shogo Sakanaka^{A)}, Takeshi Takahashi^{A)}, Takaaki Furuya^{A)}, Kenji Shinoe^{B)},

Atsushi Ishii^{B)}, Norio Nakamura^{B)}, Masaru Sawamura^{C)}

^{A)} KEK, Highi Energy Accelerator Research Organization

1-1 Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, 305-0801

^{B)} Institute for Solid State Physics, University of Tokyo

5-1-5 Kashiwanoha Kashiwa-shi, Chiba, Japan, 277-8581

^{C)} Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

2-4 Shirane Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken, 319-1195

Abstract

We started to develop an input coupler for a 1.3GHz ERL superconducting cavity. Required input power is about 20kW for the cavity acceleration field of 20MV/m and the beam current of 100 mA in energy recovery operation. The input coupler is designed based on the STF-BL input coupler and some modifications are applied to the design for the CW 20kW power operation. We fabricated input coupler components such as ceramic windows and bellows and carried out the high-power test of the components by using a 30kW IOT power source and a test stand constructed for the high-power test. In this report, we mainly describe the results of the high-power test of ceramic window and bellows.

ERL主ライナックのための1.3GHz入力カプラーの開発 -- 30kW IOTを用いたカプラーコンポーネントテスト--

1. 基本設計

1.3GHzERL用主ライナックにおいて想定されて いるCW超伝導空洞は最大加速勾配20MV/mで、最大 ビーム電流は100mAである。入力カプラーに投入 されるパワーは、エネルギー回収下では従来ほと んどパワーを供給する必要はないが、実際の運転 では外乱による影響(microphonics)などにより空 洞が機械的振動を受け、運転周波数に空洞の共振 周波数peakに保つことは難しい。従って、入力カ プラーのカップリングを変化させ、負荷Q値(Q₁) を小さくすることで共鳴幅を敢えて大きくさせ、 機械的振動に堅牢なパワーの安定供給を実現する 必要がある。表1がERL主ライナックの基本パラ メータとなる。入力電力は20kWを想定する必要が ある。

| 周波数 | 1.3GHz |
|------------------------|---|
| 加速勾配 | 15-20MV/m |
| 入力電力 | 最大20kW |
| 負荷Q値(Ql) | $5 \times 10^6 \sim 2 \times 10^7$ (可変) |
| ます シンプレートオーム・ポントのサークレビ | |

表1:主ライナック入力カプラーの基本仕様

次に図1に入力カプラーの概念図を示す。具体 的設計としては、1.3GHzにてパルス運転での大電 力試験の実績があるILC用STF-BL空洞の入力カプ ラーを基本とした[1]。セラミック窓には500MHz で運転していたTRISTANやKEKBにて実績のあるト リスタンタイプの同軸型窓を1.3GHz用に拡張して 使用している。この点が採用を決めた理由の一つ である。但し、パルス運転のILCとは異なり、CW では20kWのpower供給が要求されているため、熱 負荷の影響が大きく、いくつかの設計の改良を 行った。[2]



図1:入力カプラーの概念図。

主な変更点として、同軸部のインピーダンスを 50Ωから60Ωにし、内導体の電力損失の軽減を 行った。また、セラミック窓の材質も誘電損失の 少ない99.7%純度のアルミナセラミックス(HA997) を窓材に採用した。大気中から真空中にRFを導 入するセラミック窓は空洞への粉塵混入を避ける ため低温部(cold窓)と高温部(warm窓)の2つを設 け、特に製作の簡便性から2つを同一寸法とした。 導体は熱侵入を減らすため、1mmのSUSに10µmの銅 鍍金を施した。パルス超伝導空洞用入力カプラー と比べてRF投入時のdynamic lossが圧倒的に大き

¹ E-mail: sakai.hiroshi@kek.jp

く、60Ωのインピーダンスにしても外導体の発熱 で7.7W、内導体の発熱で20.8Wになっている。セ ラミック窓の発熱はHA997を採用することにより 一枚あたり1Wに抑えている。これらの冷却のため に、低温側の内導体の熱負荷はcold窓80Kの温度 定点をセラミック窓に設け、さらに低温側に5Kの 温度定点を設けることで、2Kの超伝導空洞への熱 侵入を0.3W程度に軽減することが可能な設計と なっている。また、常温側は内導体内部にロッド を挿入し、強制空冷により冷却する。

カプラー用のセラミック窓とベローズの試作及 びカプラー用のテストスタンドの製作を行った。 本文ではそのコンポーネントテストを行うカプ ラー試験用のテストスタンドの概要とそこでの試 験結果の現状報告を行う。最後に現カプラー製作 の問題点と今後の方針を示す。

2. カプラーテストスタンド



 $\boxtimes 2$: setup of coupler test stand

図2にテストスタンドのセットアップを示す。 1.3GHzの最大30kWのIOTを用いて、電力試験を行 う[3]。特にセラミック窓の試験がCW運転時に近 い形で行えるように、中心にcold窓を据え、その 両側をwarm窓で挟んだ3連のセラミック窓のスタ ンドとなっている。大電力試験として重要となる 発熱や温度上昇を見積もるため、セラミック窓や 外導体だけでなく、内導体にも熱電対を設置し、 特にベローズの温度上昇をモニターできるように 設計を行った。内導体にはカプラー設計と同じく ロッドを設け、内導体内部の空冷が行えるシステ ムとなっている。Warm窓の大気側からドアノブ変 換器にて導波管に変換し、一方からパワーを投入 し、他方は位相器と端板またはダミーロードを設 けている。IOT直後に1つ、スタンドの前後に1 つずつ合計3つの方向性結合器にて入力パワーの 進行波と反射波を常時モニターする。我々は図3 に示したcold窓とベローズ付のwarm窓の製作を 行った。ベローズの銅メッキのはがれやセラミッ

ク及びベローズの傷等はなく、ロウ付けの状態も 良好であった。これらをクラス6の環境下にて、 セラミック窓は超純水洗浄、外導体は高圧超純粋 洗浄を行い、テストスタンドを組み立てた。



図3: cold 窓(左写真)と warm 窓(右写真)。

3. 試験結果

次に電力試験の結果を示す。まず、常温時での 熱負荷の状況を見るべく、カプラー内の真空引き を行わずに、セラミック窓3連の状態の20kWの進 行波の大電力試験を行った。内導体のベローズの 温度上昇が大きいと思われるため、空冷の効果を 調べることも行った。



図4: (左) カプラーパワー投入時のベローズの 温度上昇。緑がベローズ中央の温度上昇を示して いる。(右) 内導体空冷ありなしでの温度上昇の 比較計算。(上) 空冷なし、(下)

図4は空冷ありなしでの内導体の温度上昇の比較を測定したものである。投入パワー1kWに対し、 室温20度からベローズの温度上昇は空冷なしで⊿ T=16度であったのに対し、内導体の空冷(流量 =601/min)を施したところ⊿T=4度であった。これ は、図4に示す空冷ありなしの計算結果(空冷な しで⊿T=25K、空冷ありで⊿T=4K)とおよそ一致し ており、ベローズの温度上昇の抑制がスムーズに 行われていることを示している。この結果にてベ ローズの温度上昇の抑制も行えていることから、 次に20kWまでパワーを投入することを試みた。図 5は20kWを投入した際のcold窓及びwarm窓の温度 上昇を示したものである。左グラフ中の赤い破線 で示すcold窓の温度が8kWのパワー投入から急激 に上昇していることが判明した。室温20度に対し、 cold窓の温度は80度以上になっている。この原因 は右グラフに示すように投入パワーの透過率が少 なくなっていることと相関があり、3連のカプ ラー窓を通過する際に何らかのパワーロスが生じ、 cold窓にて急激な温度上昇を起こしている。3回 大電力試験を行ったが同じくcold窓の急激な温度 上昇とパワーロスの相関がみられ、再現性は確認 された。



図5:カプラースタンド大電力試験時の様子。左 のグラフは黒が投入パワー(左軸)、茶色、赤 色、緑色がそれぞれ上流 warm 窓、cold 窓、下流 warm 窓の温度(右軸)を示したものである。右 のグラフは温度は同じだが、黒がカプラースタン ドに入力したパワーと透過したパワーの比(左 軸)を示したものである。

このような状況下、カプラースタンドを一度解体した所、cold窓のセラミック窓が割れているのが判明した。特に内導体の銅メッキが完全に酸化しており、想像以上の温度上昇(200度程度)が内導体で起こったものと予想された。但し、warm窓やベローズは特にメッキの劣化やセラミックの割れなどは見つからなかった。

その原因を探るべくcold窓単体、およびwarm窓 2つの単体のlow level測定を行える冶具を別途 製作し、個別にRF特性を測定した。図6がその結 果(S21)である。割れたcold窓、およびwarm窓2 つのうち、割れたcold窓と下流のwarm窓のS21が 図6と同様に1.305GHzの急峻なpeakを持つことが 判明した(図6左中の緑色の円内)。特にこの peakはセラミック窓の温度を上昇させると1.3GHz に近づく傾向があり、図5に示すhigh powerテス ト時のセラミック窓の温度がある温度(50~60度) 以上になると急激な温度上昇が見られる傾向があ り、このpeakが発熱の原因と考えられる。また、 このpeakがセラミック窓に起因することからセラ ミック窓に立つmodeをHFSSやMW-StudioによるRF simulationで詳細に調べたところ、計算では図6 の右図に示されるようにdipole modeが1.305GHz に現れることがわかった。これがpeakの原因であ る可能性が高いことがわかり、幸い、このmodeは セラミックの厚みに依存するため、セラミック窓 の厚みを変えてcold窓の製作を進める予定である。



図 6 : (左)割れた cold 窓の lowlevel 測定結果。 (S21)。(右) HFSS によるセラミック窓に立つ mode。

4. まとめ&今後

20kW 用の入力カプラーの設計を行い、セラ ミック窓とベローズの試作を行い、常温下でセラ ミック窓およびベローズの大電力試験(最大入力 パワー20kW)を行った。ベローズの温度上昇の抑 制は概ね良好であり、計算とも良い一致を示して いた。それに対し、2種類のセラミック窓の1つ (cold 窓)で急激な温度上昇が見られ、結果的に cold セラミック窓が割れる結果となった。その 後、窓単体の詳細な low level 測定を行い、セラ ミック窓の構造に起因する 1.305GHz 付近の吸収 peak が存在すること、およびそのピークが温度 上昇により 1.3GHz に近づいてくることが判明し た。とくに詳細な simulation ではセラミック窓 に起因する dipole mode が 1.3GHz 付近に存在す ることが判明し、これらの結果から想定するに、 この peak が急激な温度上昇の原因と考えられる。 従って、次年度は改良 cold 窓の製作を行い、早 急に high power 試験を行い、改善の効果を見る。 また、低温試験を行った後、これらのデータを元 にカプラーの本機の作成を行う予定である。

参考文献

- [1] 加古永治,他:「STFベースライン超伝導空洞用大電力 高周波入力結合器」,第3回加速器学会プロシーディ ング, p136-138 (2006).
- [2] 阪井寛志,他:「ERL主ライナックのための入力カプ ラーの開発現状」,第5回加速器学会,WP120 (2008).
- [3] 沢村勝:「IOT高周波出力特性」,第3回加速器学会
- プロシーディング, p832-834 (2006).